

PCN# 20141216001
一部製品 TI-FFAB,RFAB,MIHO8,DMOS6 前処理サイト及び
Carsem Suzhou 社組立/検査サイト追加認定

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただいたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20141216001	PCN 日付:	12/17/2014																															
表題:	一部製品 TI-FFAB, RFAB, MIHO8, DMOS6 前処理サイト及び Carsem Suzhou 社組立/検査サイト追加認定																																	
PCN 詳細																																		
変更内容:																																		
本変更通知は、一部製品について、追加 前処理(Fab)サイトoptionsとしてTI- FFAB, RFAB, MIHO8, DMOS6サイト、及び 追加 組立/検査サイトoptionとしてCarsem Suzhou社サイト(CSZ)の追加を連絡するためのものです。部材の違いは下記の通りです。 Group 1 Devices: Adding MIHO8 Fab Site & CSZ Assembly Site Fab Site: <table border="1"> <tr> <td>Current Site, Process, Wafer Diameter</td> <td>Additional Site, Process, Wafer Diameter</td> </tr> <tr> <td>RFAB, LBC7, 300mm</td> <td>MIHO8, LBC7, 200mm</td> </tr> </table> Assembly Site: <table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>Clark-AT</td> <td>Carsem Suzhou (CSZ)</td> </tr> <tr> <td>Mount compound</td> <td>4207123</td> <td>435143</td> </tr> <tr> <td>Mold compound</td> <td>4208625</td> <td>441086</td> </tr> <tr> <td>Bond Wire/Diameter</td> <td>Cu (1.98mil)</td> <td>Cu (2.0mil)</td> </tr> <tr> <td>Leadframe</td> <td>4221018</td> <td>442438</td> </tr> </table> Group 2 Devices: Adding RFAB Fab Site Fab Site: <table border="1"> <tr> <td>Current Site, Process, Wafer Diameter</td> <td>Additional Site, Process, Wafer Diameter</td> </tr> <tr> <td>MIHO8, LBC7, 200mm</td> <td>RFAB, LBC7, 300mm</td> </tr> </table> Group 3 Devices: Adding FFAB Fab Site Fab Site: <table border="1"> <tr> <td>Current Site, Process, Wafer Diameter</td> <td>Additional Site, Process, Wafer Diameter</td> </tr> <tr> <td>RFAB, LBC7, 300mm</td> <td>FFAB, LBC7, 200mm</td> </tr> </table> Group 4 Devices: Adding DMOS6 Fab Site Fab Site: <table border="1"> <tr> <td>Current Site, Process, Wafer Diameter</td> <td>Additional Site, Process, Wafer Diameter</td> </tr> <tr> <td>DM5, HPE035, 200mm</td> <td>DM6, HPE035, 300mm</td> </tr> </table> Test coverage内容、条件は、現行テストと一致しており、テスト生産性認定試験(Test MQ)にて検証されます。 変更理由: 供給確保 外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項: なし				Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter	RFAB, LBC7, 300mm	MIHO8, LBC7, 200mm	Material	Clark-AT	Carsem Suzhou (CSZ)	Mount compound	4207123	435143	Mold compound	4208625	441086	Bond Wire/Diameter	Cu (1.98mil)	Cu (2.0mil)	Leadframe	4221018	442438	Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter	MIHO8, LBC7, 200mm	RFAB, LBC7, 300mm	Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter	RFAB, LBC7, 300mm	FFAB, LBC7, 200mm	Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter	DM5, HPE035, 200mm	DM6, HPE035, 300mm
Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter																																	
RFAB, LBC7, 300mm	MIHO8, LBC7, 200mm																																	
Material	Clark-AT	Carsem Suzhou (CSZ)																																
Mount compound	4207123	435143																																
Mold compound	4208625	441086																																
Bond Wire/Diameter	Cu (1.98mil)	Cu (2.0mil)																																
Leadframe	4221018	442438																																
Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter																																	
MIHO8, LBC7, 200mm	RFAB, LBC7, 300mm																																	
Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter																																	
RFAB, LBC7, 300mm	FFAB, LBC7, 200mm																																	
Current Site, Process, Wafer Diameter	Additional Site, Process, Wafer Diameter																																	
DM5, HPE035, 200mm	DM6, HPE035, 300mm																																	

注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TIの公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例：

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order/Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等